

# RDA5981X AT 指令集

版本号	描述	时间
Version1.0	初始版本	2017.09.19

更多信息请访问RDA IOT论坛:

http://bbs.rdamicro.com



# 指令格式

### 指令类型:

设置指令: AT+ <x>=&lt;&gt;</x>	eg: AT+WRF_DEF=0xDA,0x80
查询指令: AT+ <x>=&lt;&gt;</x>	eg: AT+RRF_DEF=0xDA
执行指令: AT+ <x></x>	eg: AT+RST

### 返回值:

+ok	执行成功
+ok=<>	执行成功且有返回信息
+error=err code	执行失败并返回错误码

#### err code:

-1	无此指令
-2	不允许执行
-3	执行失败
-4	参数有错误

注: 1.指令一律使用大写。

2.参数部分以","分隔,字符串部分建议使用引号,防止包含特殊符号时出错。

3.未具体解释的指令均为执行指令,直接执行即可。



# 基础指令

AT	测试 AT 模式是否使能
AT+H	查看 AT 帮助信息
AT+RST	重启模块
AT+VER	查看软件版本
AT+ECHO	打开或者关闭串口回显,启动后默认为打开
AT+ECHO=1/0	1表示打开,0表示关闭
AT+WDBG	调整各模块的 debug level
AT+WDBG=DRV,2	调整 driver debug level,级别为 0~3,默认为
	0
AT+WDBG=WPA,2	调整 wpa debug level,级别为 0~3,默认为 0
AT+WDBG=DRVD,1	打开/关闭 driver dump,会打印出收发的数
	据,1为打开,0为关闭,默认为关闭
AT+WDBG=WPAD,1	打开/关闭 WPA dump,会打印出某些数据,1
	为打开,0为关闭,默认为关闭



# efuse 指令

指令中开始的 R 表示 Read,W 表示 Write。最后的 E 表示 efuse。所有写入的参数必须为 16 进制,1 个 byte。

AT+RE	读取所有 efuse 内容

efuse 共 16 个 page,每个 page2 个 bytes。用户可以读出 page2~15 的内容,读出的内容按照[page2 byte0] [page2 byte1] [page3 byte0] ... [page15 byte1]排列。

page	byte1	byte0
page0	rda_reserved	
page1	rda_reserved	
page2	usb pid	
page3	usb vid	
page4	mac address[4]	mac address[5]
page5	mac address[2]	mac address[3]
page6	mac address[0]	mac address[1]
page7	mac address[4]_bak	mac address[5]_bak
page8	mac address[2]_bak	mac address[3]_bak
page9	mac address[0]_bak	mac address[1]_bak
page10	crystal_cal_bak1	crystal_cal
page11	crystal_cal_bak3	crystal_cal_bak2
page12	rda_reserved:Bit[12~15] Tx_power: Bit[6~11]:b mode Bit[0~5]:g/n mode	
page13	rda_reserved:Bit[12~15] Tx_power_bak1: Bit[6~11]:b mode Bit[0~5]:g/n mode	
page14	rda_reserved:Bit[12~15] Tx_power_bak2: Bit[6~11]:b mode Bit[0~5]:g/n mode	
page15	rda_reserved:Bit[12~15]	
	Tx_power_bak3: Bit[6~11]:b mode Bit[0~5]:g/n mode	

Table 1 efuse page 分区信息



AT+WTPE 写 tx power 到 efuse

AT+WTPE=n1,n2

n1 为 11g/n 模式下的 TX POWER,范围为 0x25~0x64。 n2 为 11b 模式下的 TX POWER,范围为 0x15~0x54。 最多写入四次。

AT+RTPE

从 efuse 读取 tx power

返回数据格式与写入数据格式相同。 多次写入 tx power 时,返回最后写入值。

AT+WXCE

写晶体校准值到 efuse

AT+WXCE=n1

n1 为 1 个 byte,取 bit7~bit1,bit0 无效。 最多可以写入四次。

AT+RXCE

从 efuse 读晶体校准值

返回的数据格式与写入的数据格式相同。 多次写入晶体校准值时,返回最后写入值。

AT+WMACE

写 MAC 地址到 efuse

AT+WMACE=n1,n2,n3,n4,n5,n6 n1 的最低位不能为 0, n1~n6 不能全为 0。 最多写入两次。

AT+RMACE

从 efuse 读 MAC 地址

返回的数据格式与写入的数据格式相同。 多次写入 MAC 地址时,返回最后写入值。



### RF 寄存器通用指令

开始的 R 表示 Read, W 表示 Write。所有的寄存器地址和值必须为 16 进制,channel 可以为 10 进制。

在进行 Read 时,\_CUR 表示从寄存器读取,\_DEF 表示从 flash 读取。进行 Write 时,\_CUR 表示只写入寄存器,\_DEF 表示写入寄存器的同时写入 flash。

AT+WRF\_CUR

写 RF 寄存器

AT+WRF CUR=n1,n2

n1,n2 均为 half word。n1 为寄存器地址,n2 为要写入的值。eg: AT+WRF\_CUR=0xDA,0x80

AT+RRF\_CUR

读 RF 寄存器

AT+RRF CUR=n1

n1 为寄存器地址,half word。返回的数据格式与写入的数据格式相同。eg: AT+RRF\_CUR=0xDA

AT+WRFAC\_CUR

写 RF 寄存器,此寄存器与 channel 有关

AT+WRFAC CUR=n1,n2,n3,...,n15

n1~n15 均为 half word。n1 为寄存器地址,n2~n15 依次为 channel1~14 的值。eg: AT+WRFAC CUR=0x8A,0x69A0,0x69A0,...,0x6820

AT+RRFAC\_CUR

读 RF 寄存器,此寄存器与 channel 有关

AT+RRFAC CUR=n1

n1 为寄存器地址,half word。返回的数据格式与写入的数据格式相同。

eg: AT+RRFAC\_CUR=0x8A



AT+WRFSC\_CUR

写 RF 寄存器,只写某个 channel 的值

AT+WRFSC\_CUR=n1,n2,n3

n1 和 n3 为 half word。n1 为寄存器地址,n2 为 channel,n3 为要写入的值。eg: AT+WRFSC\_CUR=0x8A,1,0x69A0

AT+RRFSC\_CUR

读 RF 寄存器,只读某个 channel 的值

AT+RRFSC\_CUR=n1,n2

n1 为寄存器地址,half word。n2 为 channel。返回的数据格式与写入的数据格式相同。eg: AT+RRFSC\_CUR=0x8A,1

AT+WRF DEF

同时写 RF 寄存器和 flash

AT+WRF\_DEF=n1,n2

n1,n2 均为 half word。n1 为寄存器地址,n2 为要写入的值。

eg: AT+WRF\_DEF=0xDA,0x80

AT+RRF\_DEF

从 flash 读取 RF 寄存器值

AT+RRF\_DEF=n1

n1 为寄存器地址,half word。返回的数据格式与写入的数据格式相同。

eg: AT+RRF\_DEF=0XDA



AT+WRFAC_DEF	同时写 RF 寄存器和 flash,此寄存器与 channel
	有关

AT+WRFAC\_DEF=n1,n2,n3,...,n15

n1~n15 均为 half word。n1 为寄存器地址,n2~n15 依次为 channel1~14 的值。eg: AT+WRFAC\_DEF=0x8A,0x69A0,0x69A0,...,0x6820

AT+RRFAC_DEF	从 flash 读取 RF 寄存器值,此寄存器与
	channel 有关

#### AT+RRFAC\_DEF=n1

n1 为寄存器地址,half word。返回的数据格式与写入的数据格式相同。

eg: AT+RRFAC\_DEF=0x8A

AT+WRFSC_DEF	同时写 RF 寄存器和 flash,只写某个 channel
	的值

#### AT+WRFSC\_DEF=n1,n2,n3

n1 和 n3 为 half word。n1 为寄存器地址,n2 为 channel,n3 为要写入的值。

eg: AT+WRFSC\_DEF=0x8A,1,0x69A0

AT+RRFSC_DEF	从 flash 读取 RF 寄存器值,只读某个 channel
	的值

#### AT+RRFSC\_DEF=n1,n2

n1 为寄存器地址,half word。n2 为 channel。返回的数据格式与写入的数据格式相同。eg: AT+RRFSC\_DEF=0x8A,1



AT+DRF	dump flash 中保存的 RF 寄存器及其对应的值

AT+ERF 擦除 flash 中保存的 RF 寄存器及其对应的值

AT+ERF=n1

n1 为寄存器地址,half word。

eg: AT+ERF=0xDA

AT+DRFAC	dump flash 中保存的与 channel 相关 RF 寄存
	器及其对应的值

AT+ERFAC	擦除 flash 中保存的与 channel 相关 RF 寄存器
	及其对应的值

AT+ERFAC=n1

n1 为寄存器地址,half word。

eg: AT+ERFAC=0x8A



### PHY 寄存器通用指令

开始的 R 表示 Read, W 表示 Write。所有的寄存器地址和值必须为 16 进制,channel 可以为 10 进制。

在进行 Read 时,\_CUR 表示从寄存器读取,\_DEF 表示从 flash 读取。进行 Write 时,\_CUR 表示只写入寄存器,\_DEF 表示写入寄存器的同时写入 flash。

AT+WPHY\_CUR

写 PHY 寄存器

AT+WPHY CUR=n1,n2

n1,n2 均为 word。n1 为寄存器地址, n2 为要写入的值。

eg: AT+WPHY\_CUR=0x11F,0x45

AT+RPHY CUR

读 PHY 寄存器

AT+RPHY CUR=n1

n1 为寄存器地址,word。返回的数据格式与写入的数据格式相同。

eg: AT+RPHY\_CUR=0x11F

AT+WPHY\_DEF

同时写 PHY 寄存器和 flash

AT+WPHY DEF=n1,n2

n1,n2 均为 word。n1 为寄存器地址, n2 为要写入的值。

eg: AT+WPHY\_DEF=0x11F,0x45

AT+RPHY\_DEF

从 flash 读取 PHY 寄存器值

AT+RPHY DEF=n1

n1 为寄存器地址, word。返回的数据格式与写入的数据格式相同。

eg: AT+RPHY\_DEF=0x11F



AT+WTPOFS_DEF	写 11g 与 11n Tx Power 偏置到 flash

AT+WTPOFS\_DEF=n1

n1 为 11g 与 11n 的偏置,取值范围 0x0~0xF。

eg: AT+WTPOFS\_DEF=0x5

AT+RTPOFS_DEF	从 flash 读取 11g 与 11n Tx Power 偏置
AT+DPHY	dump flash 中保存的 PHY 寄存器及其对应的值
AT+EPHY	擦除 flash 中保存的 PHY 寄存器及其对应的值

AT+EPHY=n1

n1 为寄存器地址,half word。

eg: AT+EPHY=0x11F



# 读写 MAC 地址指令

开始的 R 表示 Read,W 表示 Write。读写 MAC 地址比较特殊,\_DEF 只写入 flash 和只从 flash 读取。

MAC 地址必须为 16 进制。

AT+WMAC\_DEF

写 MAC 地址,只写入 flash

AT+WMAC\_DEF=n1,n2,n3,n4,n5,n6 n1~n6 为 MAC 地址,均为 1 个 byte。 eg: AT+WMAC\_DEF= 0x64,0x20,0xAB,0xC1,0x1D,0x34

AT+RMAC\_DEF

读 MAC 地址,从 flash 中读取



### HUT 模式下收发测试指令

通过以下指令,可以进入测试模式。指令中所有参数都是10进制。

AT+TXSTART 开始 TX 测试

#### AT+TXSTART=n1,n2,n3,n4,n5,n6

n1: 主信道,取值范围 1~14。

n2:模式,0代表 b/g mode,1代表 11n green field mode,2代表 11n mixed mode。

n3: 信道带宽, 0 代表 20M, 1 代表 40M。

n4: 信号带宽, 0 代表全 40M, 1 代表主信道为 upper, 2 代表 20M, 3 代表主信道为 lower。

n5: 速率,11b/g 模式取值为1256911121824364854。11n 模式取值为0~7,代表 mcs0到 mcs7。

n6: 发送包长,单位为 byte。

注意: 在信道带宽为 40m 时,若主信道为 1~4,信号带宽只能选择 0 或者 3,若主信道为 10~13,信号带宽只能选择 1。

eg: AT+TXSTART=1,0,0,2,54,1024

AT+TXSTOP	停止 TX 测试

AT+TXRESTART	按照上次的配置重新开始 TX 测试

仅在上一次测试为 TX 测试才有效。



AT+RXSTART 开始 RX 测试

AT+RXSTART=n1,n2,n3,n4 n1~n4 的定义与 TX 测试相同,RX 测试不需要设置速率和包长。 eg: AT+RXSTART=1,0,0,2

当 AT+RXSTART= n1,n2,n3,n4 指令下发后,会持续统计 RX 测试结果,每下发一次 AT+RXRESULT 指令,就会上报一次 RX 测试结果。

AT+RXSTOP 停止 RX 测试

AT+RXRESTART 按照上次的配置重新开始 RX 测试

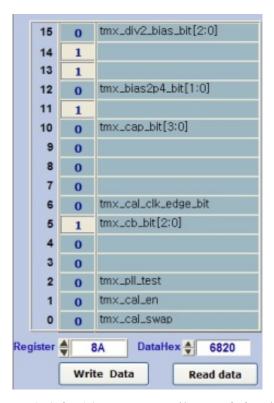
仅在上一次测试为 RX 测试才有效。



### 寄存器介绍

### 0x8A 寄存器

**0x8A** 寄存器是 RF 寄存器,共 **16bit**, 其中 **bit7~bit10** 用来调节模拟增益,其他位禁止改动。 **0x8A** 默认为 **0x6820**。



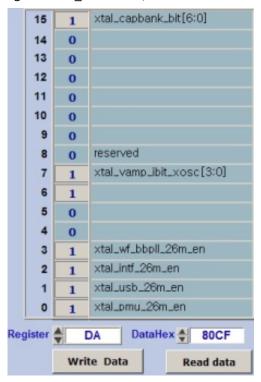
可以通过配置 channel1~14 的 0x8A 寄存器值将信道功率调平。在调节 0x8A 寄存器时,数字增益保持不变。确定好一组 0x8A 寄存器值后,就可以通过校准数字增益来达到目标功率。校准时需要将这组 0x8A 寄存器值写入 flash,模块上电后驱动会调用相应信道的 0x8A 值配入 firmware。



# 0xDA 寄存器

OxDA 寄存器是 RF 寄存器,共 16bit,其中 bit9~bit15 用来调节晶体频偏,其他位禁止改动。 OxDA 默认为 Ox80CF。AT 指令接口已经将低 8 位固定为 OxCF,所以通过 AT 指令修改 OxDA 值,只需填写高 8 位的值即可。

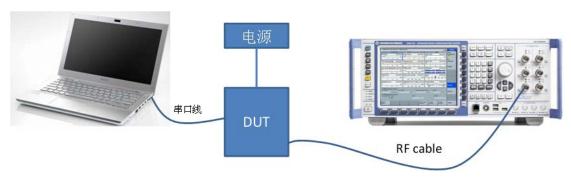
eg. AT+WRF\_CUR=0xDA,0x80



注:由于 bit8 为保留位,且值始终为 0,所以写入 0xDA 高 8 位值为偶数。



### 校准环境

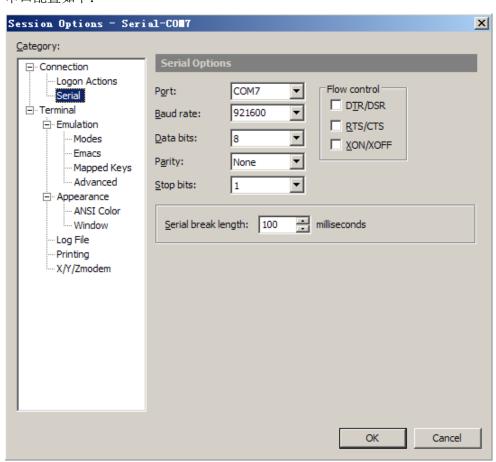


### 测试设备:

- 1. CMW500(或其他厂商 WLAN 测试仪表)
- 2. 直流稳压电源
- 3. PC
- 4. 串口线、RF测试电缆

#### 串口配置

打开串口工具 SecureCRT 串口配置如下:





Port: 选择电脑识别串口

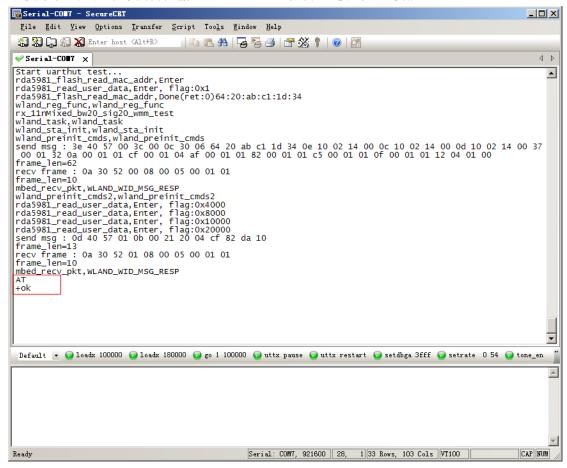
Baud rate: 921600

Data bits: 8

Parity: None

Stop bits: 1

连接好串口后在命令编辑栏输入 AT, 返回 OK 说明 AT 模式已经使能。





### TX Power 测试及校准

1. 通过 AT+TXSTART 指令,使 RDA5981X 模块处于发射状态。 eg. AT+TXSTART=1,2,0,2,7,1024 模块处于 11n 20M Mixed MCS7 发射模式

2. 仪表端读数如下:



其中 Burst Power 既是 TX Power 的测量值, EVM、Freq Error、Symbol Clock Error、IQ Offset、Gain Imbalance 以及 Quadrature Error 都是 TX 测试比较关注的内容

3. RDA5981X TX Power 数字增益寄存器类型为 PHY 寄存器,地址如下:

 0x11F
 调节 11g/n TX Power 数字增益

 0x120
 调节 11b TX Power 数字增益

若当前 TX Power 未在所需范围内,可以通过如下方式调节:

11g/n AT+WPHY\_CUR=0x11F,n1 11b AT+WPHY\_CUR=0x120,n1

对于 11b, 在目标功率  $(16\sim18)$  dbm 区间内,寄存器每改变 1bit, 功率值变化 0.15db 对于 11g/n, 在目标功率  $(12\sim14)$  dbm 区间内,寄存器每改变 1bit, 功率值变化 0.12db

注: 寄存器每改变 1bit 对应的功率变化并不是严格等于以上值

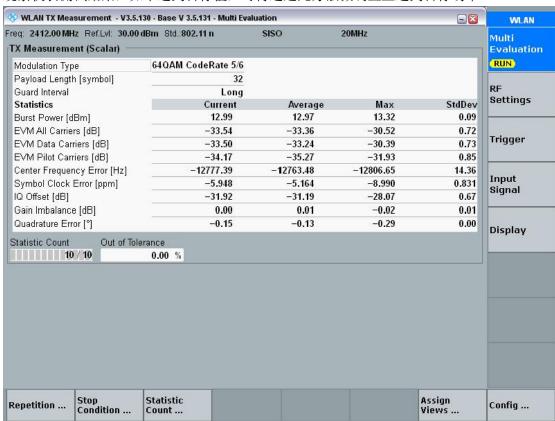


例如,如上测试模块 TX Power 为 14.83dbm,通过 AT+RPHY\_CUR=0x11F 可得知当前 0x11F 寄存器值为 0x45,我们希望将 TX Power 降至 13dbm,那么寄存器相应降低 15bit,TX Power 基本就接近目标功率了。

可以通过如下指令实现:

AT+WHY\_CUR=0x11F,0x36

观察仪表测试结果,如未达到目标值,可再通过此方法微调直至达到目标功率



4. 当 TX Power 校准至目标功率值后,将寄存器值写入 flash,指令如下:

11g/n AT+WPHY\_DEF=0x11F,n1 11b AT+WPHY\_DEF=0x120,n1

5. 当 11g/n 目标功率不一致时,可以通过设置偏置来实现,该偏置值需要在校准时写入 flash, 指令如下:

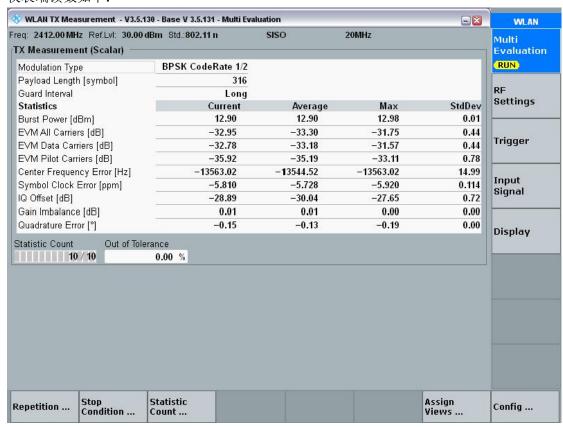
#### AT+WTPOFS\_DEF=n1

n1 为 11g 与 11n 数字增益差值,11g 在 11n 数字增益的基础上加上此偏置值即为 11g 的数字增益。n1 为 16 进制,取值范围  $0x0^{\circ}0xF$ 。



### 晶体频偏测试及校准

- 通过 AT+TXSTART 指令,使 RDA5981X 模块处于发射状态。
   eg. AT+TXSTART=1,2,0,2,0,1024 模块处于 11n 20M Mixed MCS0 发射模式 建议在低速率下去校准晶体频偏
- 2. 仪表端读数如下:



Symbol Clock Error 即为当前晶体频偏

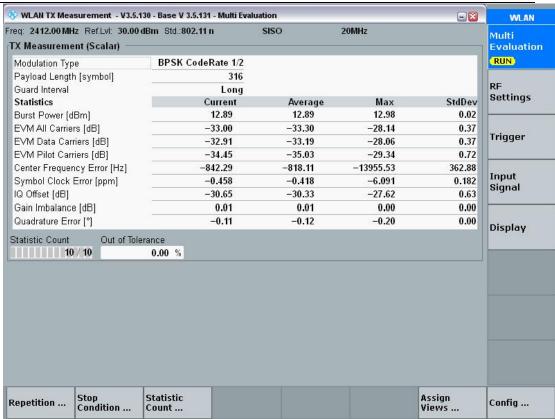
3. 可以通过 AT+WRF\_CUR 来调节晶体频偏,指令如下: AT+WRF CUR=0XDA,n1

其中 n1 是寄存器值,为十六进制数,范围 0x02~0xFE,通常默认 0x80

如果频偏为负偏,可以通过增加寄存器值来修正频偏,使频偏接近 0ppm。如果频偏为 正偏,可以通过减小寄存器值来使频偏接近 0ppm。

例如上面测试晶体频偏为-5ppm,通过AT+RRF\_CUR=0xDA 得知当前 0xDA 寄存器值为 0x80,需要增加寄存器值来使频偏接近 0ppm,我们可以通过 AT+WRF\_CUR=0XDA,0x90 修改 0xDA 寄存器值为 0x90,观察仪器读数,直至频偏接近 0ppm。





注: 晶体频偏变化与寄存器值变化值对应关系与晶体型号有关,需要前期对晶体进行测量得出。

4. 当晶体频偏校准至 Oppm 后,将 OxDA 寄存器值写入 flash,指令如下: AT+WRF\_DEF=0XDA,n1